

半 导 体 学 报

第 8 卷 第 3 期 1987 年 5 月

目 录

- 调制掺杂非晶半导体超晶格中的瞬变电流 (I)
——稳恒电场中载流子的运动.....熊诗杰 (225)
- 硅中金施主和受主光电性质的系统研究.....王占国 (236)
- 固相反应形成硅化钛薄膜方法及特性研究.....
.....洪 汎 李炳宗 姜国宝 黄维宁 张强基 费 璐 (247)
- Ti/Si 和 Ti/SiO₂/Si 系统硅化物的形成...李宝骐 王佑祥 殷士端 许振嘉 (254)
- Ni 在 Si(111) 和 Si(100) 面上吸附的理论研究.....
.....田曾举 张开明 叶 令 谢希德 (261)
- LSIS-2 自动布图设计系统
.....庄文君 程可行 薄建国 牛征虎 高春华 易涪兰 (270)
- 关于 N-Si:Pd 中能级 E(0.37) 和 E(0.62) 的识别.....
.....周 洁 阮圣央 郝 烜 葛惟锬 吉秀江 李树英 (277)
- P 型 LEC-GaAs 中双重受主态的研究.....江德生 宋春英 何宏家 许振嘉 (283)
- 键轨道的近似计算.....钟学富 (291)

研 究 简 报

- 硅中铁对氧碳沉淀的影响.....张一心 (300)
- GaP(111)-1×1 表面的 Ga3d 化学位移.....邢益荣 (305)
- Si 中注 Pb 的红外瞬态退火.....
.....殷士端 张敬平 顾 诤 许振嘉 刘家瑞 章其初 李大万 (308)
- Pd 在 P-Si 中的物理行为.....
.....周 洁 阮圣央 郝 烜 葛惟锬 吉秀江 李树英 (312)
- HEMT 电子迁移率与器件参数关系.....赵冷柱 (316)
- a-Si:H 的低温电导及其 Staebler-Wronski 效应的研究.....周江淮 孔光临 (321)
- 应用电子辐照技术控制功率开关晶体管少子寿命的研究.....
.....柴天恩 乔 健 麦淑贤 郑继义 常保延 (325)

研 究 快 报

- GaAs-GaAlAs 多量子阱结构发光的激子性质和温度特性.....
徐仲英 梁基本 许继宗 郑宝真 李玉璋 徐俊英 曾一平 葛惟锬 (329)
- Si(001)-(2×1) 的金属性表面态.....徐亚伯 陈晓华 李海洋 (334)